

1N700 Series

シリコンエピタキシャルプレーナ形 400mW 定電圧ダイオード Silicon Epitaxial Planar 400mW Zener Diodes

● 特長

- 1) ガラス封止である (JEDEC : DO-35)。
- 2) 高信頼である。

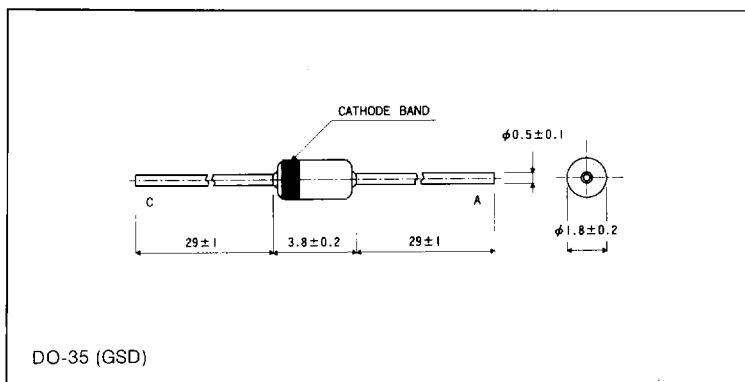
● Features

- 1) Glass sealed type (JEDEC : DO-35).
- 2) High reliability.

● 用途

定電圧制御用

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● Applications

Voltage regulator.

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
許容損失	P	400	mW
接合部温度	Tj	175	°C
保存温度範囲	Tstg	-65~+175	°C

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic (Ta=25°C)

Type	Suffix	ツェナー電圧			動作抵抗		逆方向電流	
		V _z (V)			Z _z (Ω)		I _R (μA)	
		Min.	Max.	I _z (mA)	Max.	I _z (mA)	Max.	V _R (V)
1N746	Non	2.97	3.63	20	28	20	10	1
	A	3.14	3.47					
1N747	Non	3.24	3.96	20	24	20	10	1
	A	3.42	3.78					
1N748	Non	3.51	4.29	20	23	20	10	1
	A	3.71	4.10					
1N749	Non	3.87	4.73	20	22	20	2	1
	A	4.09	4.52					
1N750	Non	4.23	5.17	20	19	20	2	1
	A	4.47	4.94					
1N751	Non	4.59	5.61	20	17	20	1	1
	A	4.85	5.36					

(次のページへつづく)

Type	Suffix	ツェナー電圧			動作抵抗		逆方向電流	
		V_Z (V)			Z_Z (Ω)		I_R (μA)	
		Min.	Max.	I_Z (mA)	Max.	I_Z (mA)	Max.	V_R (V)
1N752	Non	5.04	6.16	20	11	20	1	1
	A	5.32	5.88					
1N753	Non	5.58	6.82	20	7	20	0.1	1
	A	5.89	6.51					
1N754	Non	6.12	7.48	20	5	20	0.1	1
	A	6.46	7.14					
1N755	Non	6.75	8.25	20	6	20	0.1	1
	A	7.13	7.88					
1N756	Non	7.38	9.05	20	8	20	0.1	1
	A	7.79	8.61					
1N757	Non	8.19	10.01	20	10	20	0.1	1
	A	8.65	9.56					
1N758	Non	9.00	11.00	20	17	20	0.1	1
	A	9.50	10.50					
1N759	Non	10.80	13.20	20	30	20	0.1	1
	A	11.40	12.60					

(1) ツェナー電圧 (V_Z) は、定常状態で測定します。

(2) 動作抵抗 (Z_Z) は規定電流 (I_Z) に微小交流電流を重ねて測定します。

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves ($T_a=25^\circ C$)

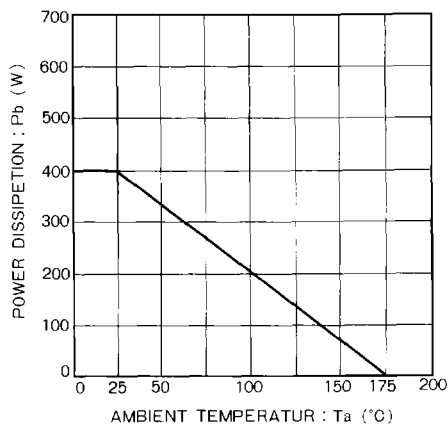


Fig.1 ディレーティングカーブ

定電圧ダイオード

定電圧ダイオード